PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number .:

(43)Date of publication of application: 04.07.1995

(51)Int.CI.

H01F 1/14

H01F 17/06 H01F 41/02

(21)Application number: 05-313005

(22)Date of filing:

14.12.1993

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(72)Inventor:

BIZEN YOSHIO

NAKAJIMA SUSUMU YOSHIZAWA KATSUTO ARAKAWA SHUNSUKE

MIKI HIROHIKO TAMAKAI TOSHIYUKI

(54) MAGNETIC CORE AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a thin toroidal magnetic core suitable for the pulse transformer magnetic core for interface, etc., or a choke magnetic core for a noise filter or the like.

CONSTITUTION: In a magnetic core consisting of a toroidal magnetic core substrate, where a thin superfine crystal soft magnetic allay band is wound, and a coating layer covering its outside, the edge of the toroidal magnetic substrate is chamfered.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-169612

(43)公開日 平成7年(1995)7月4日

(51) Int. C1.6	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01F	1/14		•	
	17/06 H	8123-5 E		
	41/02 A			
			H01F	1/14 Z
				*
	審査請求 未請求	請求項の数11	ΟĻ	(全6頁)
. 4			•	
(21)出願番号	特願平5-313005	•	(71)出願人	000005083
	,			日立金属株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)12	月14日		東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
			(72)発明者	備前 嘉雄
2			8	埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式
				会社磁性材料研究所內
	9		(72)発明者	
				埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式
		•		会社磁性材料研究所内
			(72)発明者	
· X	. "//"		(12/)1914	埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式
4		*		
			(7.4) (ETH 1	会社磁性材料研究所内
	•		(74)代理人	
•				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】磁心およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 インターフェース用等のパルストランス磁心 やノイズフィルター用チョーク磁心等に適する薄型トロ イダル磁心の提供。

【構成】 超微結晶軟磁性合金薄帯を巻回してなるトロイダル磁心基体と、その外表面を被覆するコーティング層とからなる磁心において、トロイダル磁心基体のエッジ部が面取りされていることを特徴とする磁心。

10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 超微結晶軟磁性合金薄帯を巻回してなる トロイダル磁心基体と、その外表面を被覆するコーティ ング層とからなる磁心において、トロイダル磁心基体の エッジ部が面取りされていることを特徴とする磁心。

面取り寸法が0.1~0.5mmである 【請求項2】 請求項1に記載の磁心。

【請求項3】 コーティング肉厚が5~50μmである 請求項1または2に記載の磁心。

面取り部以外のコーティング肉厚が10 【請求項4】 ~50 µmである請求項1~3のいずれかに記載の磁

【請求項5】 コーティング肉厚が20~30 μmであ る請求項1または2に記載の磁心。

【請求項6】 コーテイング層がポリパラキシリレン系 樹脂からなる請求項1~5のいづれかに記載の磁心。

【請求項7】 液体急冷法により作成された幅が0.5 ~3mmの超微結晶何時整合金薄帯を巻回してなる請求 項1~6のいずれかに記載の磁心。

【請求項8】 液体急冷法により作製された幅が0.5 ~2 mmの超微結晶軟磁性合金薄帯を巻回してなる請求 項1~7のいずれかに記載の磁心。

【請求項9】 液体急冷法により作製された板厚が5~ 30μmの超微結晶軟磁性合金薄帯を巻回してなる請求 項1~8のいずれかに記載の磁心。

【請求項10】 液体急冷法により作製された板厚が1 0~25 μmの超微結晶軟磁性合金薄帯を巻回してなる 請求項1~9のいずれかに記載の磁心。

【請求項11】 超微結晶軟磁性合金薄帯を巻回してな るトロイダル磁心基体と、その外表面を被覆するコーテ ィング層とからなる磁心の製造方法において、 晶軟磁性合金薄帯を巻回してトロイダル磁心基体を得る

トロイダル磁心基体の外表面をコーティングする工程

トロイダル磁心基体のエッジ部を面取り加工を施す工程

再度トロイダル磁心基体の外表面をコーティングする工 程と、からなることを特徴とする磁心の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はインターフェース用等の パルストランスあるいはノイズフィルタ用チョーク等に 使用される小型、薄型の磁心に関するものである。

[[0002]

【従来の技術】近年、表面実装技術の進歩により電子機 器の小型化、薄型化、髙機能化が急速に進展している。 これに伴いコイル部品にも小型、薄型で高性能な表面実 装品が強く求められている。例えば、ISDNのインターフ エース用パルストランスには、小型、薄型で高周波伝送 50 ル磁心を提供することである。

特性に優れることが要求される。すなわち、インダクタ ンスが大きい、巻線間容量が小さい、入出力巻線間の結 合が高い等が要求される。また、過酷な使用環境に耐え られるだけの十分な温度特性も必要とされる。

【0003】現在、この用途には主にフェライトが使用 され、高さ3mm程度の小型、薄型パルストランスが実 用化されている。しかし、フェライトの透磁率は高々1 0000程度と小さいため、パルストランスに用いた場 合、所定のインダクタンスを得るために巻線数が多くな り巻線間容量が増大し、十分な伝送特性が得られないば かりでなく、透磁率の温度特性が悪いため伝送特性が不 安定となりやすいことや、小型、薄型で高透磁率のフェ ライトを製造することが困難である等の問題があった。

【0004】近年、超微結晶軟磁性合金等に代表される 液体急冷法により作製される磁性合金薄帯を用いたトロ イダル磁心が注目され、各種インダクタンス素子として 使用されている。特開平2-295101号にはフェラ イトに比べ透磁率の高い超微結晶軟磁性合金を用いた、 ISDNのインターフェース変成器用磁心が開示されてい

る。ここでは、液体急冷法により製造された幅6mmの 20 超微結晶軟磁性合金薄帯を外径14mm、内径7mm、 高さ6mmに巻回した、伝送特性に優れる磁心が開示さ れている。しかし、磁心のインダクタンスおよび薄型化 の点で不十分である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】一般に、金属磁性合金 薄帯から構成されたトロイダル磁心を用いたコイル部品 では磁心と巻線間を電気的に絶縁する必要があるため、 磁心を樹脂製のケースに収納し巻線を施したケース品 と、磁心外表面をコーティングし、巻線を施したコーテ ィング品が知られている。上述したように、コイル部品 にはますます小型化、薄型化が要求されており、これに 伴い、トロイダル磁心を構成する磁性合金薄帯の幅を狭 くし、磁心自体の高さを低くしたり、ケースやコーティ ング層の薄肉化や巻線の細線化が試みられている。しか しながら、ケース品の場合、0.2mm以下の薄肉形状 のコアケースを作製することは実用上困難であり、機械 的強度も劣るため取扱いが難しい問題がある。一方、コ ーティング品の場合、1μπ程度までの薄肉化は容易で 40 あるが、トロイダル磁心の断面は長方形形状が一般的で あるため、エッジ部のコーティング肉厚が局部的に著し く低下もしくはコーティング層が全く被覆されなくなる ため、磁心と巻線間の絶縁耐圧が低下する問題があっ た。また、磁心に巻線を施す場合に巻線の損傷が起こり やすく、巻線間の絶縁耐圧が低下するという問題も発生 することが判明した。

【0006】本発明は上記の問題点を解決するととも に、インターフェース用等のパルストランス磁心やノイ ズフィルター用チョーク磁心等に適する超薄型トロイダ [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は上記問題点 について鋭意研究を進めた結果、外表面をコーティング した長方形断面形状を有するトロイダル磁心において、 長方形断面のエッジ部を面取加工することにより、巻線 の損傷が無くなり、巻線と磁心間の絶縁耐圧が向上する こと、および高さ3mm以下の薄型で高インダクタンス の磁心が得られることを初めて見出し、本発明を創出す るに至った。

【0008】すなわち、本発明の磁心は、超微結晶軟磁 10 性合金薄帯を巻回してなるトロイダル磁心基体と、その 外表面を被覆するコーティング層とからなる磁心におい て、トロイダル磁心基体のエッジ部が面取りされている ことを特徴とする。本発明磁心の面取り寸法は、0.1 ~0.5mmであることが望ましい。0.1mm未満の 場合、エッジ部のコーティング肉厚が減少するため巻線 の損傷が起こりやすくなり、巻線と磁心間の絶縁耐圧が 低下する。一方、面取寸法が0.5mmを越えると、磁 心の断面積が減少するため、所定のインダクタンスを得 るために巻線数が多くなり、巻線間の浮遊容量が増加し 20 共振を起こしやすくなるからである。

【0009】トロイダル磁心の外表面のコーティング肉 厚は、磁心に作用する応力、コーティング肉厚の均一 性、絶縁耐圧および磁心の高さの点から10~50μm が好ましく、特に20~30μmにすることで超薄型、 高インダクタンスで絶縁耐圧に優れる磁心が得られる。 また、トロイダル磁心の長方形断面のエッジ部のコーテ ィング肉厚は5μm以上が好ましい。肉厚が5μm未満で はエッジ部のコーティング肉厚が不均一となるため巻線 と磁心間の絶縁耐圧が低下する。実用的には、コーティ ング肉厚が5~50μmの場合、薄型で絶縁耐圧に優れ る磁心が得られる。コーティングに用いる材質としては ポリパラキシリレン系、フッ素系、エポキシ系、フェノ ール系、シリコン系等の樹脂、無機ワニスおよび金属ア ルコキシド等が使用できる。ポリバラキシリレン系樹脂 は、コーティング肉厚が均一で、薄肉化が容易であるこ とや、絶縁耐圧が高いため、コーティング材質として特 に望ましい。

【0010】トロイダル磁心に使用される磁性合金薄帯 の幅は、磁心の薄型化のためには3mm以下が望ましい 40 が、幅が0.5mm未満の薄帯を製造することは実用上 困難であるため、0.5~3mmの範囲が好ましい。特 $c0.5\sim2$ mmの範囲が望ましい。

【0011】また、磁性合金薄帯の板厚は、液体急冷 法、例えば単ロール法により通常製造可能な5~30μ mの範囲が望ましく、特に10~20μmの範囲が容易に 薄帯を製造できるため好ましい。薄帯の板厚は、例え ば、重量換算により以下の式によって求められる。採取 する薄帯の長さは50cm程度とすることで、再現良く板 厚が求められる。

平均板厚=重量/(密度×長さ×幅)

【0012】本発明の磁心に用いる超微結晶軟磁性合金 としては、例えば、本発明者等が提案した特開昭63-302504号、特開昭64-39347号、特開平1-142049号、特開平1-149940号、特開平1-156452号、特開平1-242755号、特開平1-242756号等が開示されており、いずれの合金も使 用できる。

【0013】また、本発明磁心は、超微結晶軟磁性合金 薄帯を巻回してなるトロイダル磁心基体と、その外表面 を被覆するコーティング層とからなる磁心の製造方法に おいて、超微結晶軟磁性合金薄帯を巻回してトロイダル 磁心基体を得る工程と、トロイダル磁心基体の外表面を コーティングする工程と、トロイダル磁心基体のエッジ 部を面取り加工する工程と、再度トロイダル磁心基体の 外表面をコーティングする工程とからなる製造方法によ って製造することができる。

【0014】以下この製造方法の望ましい態様について 説明する。先ず、単ロール法により幅0.5~3mm、 板厚5~30μ四の非晶質合金薄帯を巻回しトロイダル 磁心を作製する。次に、非晶質合金の結晶化温度以上の 450~600°Cの温度で、10分~20時間、アルゴ ンガスや窒素ガス等の不活性ガス雰囲気中、あるいは真 空中で熱処理することにより、粒径1000オングストローム 以下の超微細なbccFe結晶粒を主体とした組織を形成さ せる。熱処理は無磁界中、静磁界中、回転磁界中いずれ の条件で実施しても良い。また、特に高周波で使用する 場合は、磁心を作製する際に合金薄帯表面の少なくとも 一方の面に SiO₂やAl₂О₃等の層間絶縁膜を 30 0.1~3 µmの厚さに形成することにより磁心のインダ クタンスが一層向上するため好ましい結果が得られる。 次に、熱処理した磁心の外表面に上述したコーティング 材を用いてコーティングを施す。コーティング肉厚は5 ~10μm程度が好ましい。コーティング条件は用いる 材質に応じて最適な条件で行う。例えば、ポリパラキシ リレン系樹脂は化学蒸着によりトロイダル磁心の外表面 をコーティングする。次に、コーティングされたトロイン ダル磁心のエッジ部に 0.1~0.5 mmの面取加工を施[®] す。面取加工は磁心外表面のコーティング材の部分だけ でなく、磁心自体も面取加工により除去される。この理 由は、コーティング肉厚が数10μm程度と薄いため、 コーティング材のみ面取加工することが極めて困難なた めである。最後に面取りした磁心を再度コーティング し、磁心外表面のコーティング肉厚を10~50μm、 エッジ部のコーティング肉厚を5μm以上とする。

[0015]

【実施例】以下、本発明を実施例にしたがって説明する が本発明はこれらに限定されるものではない。

【0016】(実施例1)原子%でCu1%、Nb1 %、Si13.5%、B9%、残部実質的にFeからなる

6

組成の合金溶湯を単ロール法により急冷し、幅1mm、厚さ20μmの非晶質合金薄帯を作製した。得られた非晶質合金薄帯を外径10mm、内径5mmに巻回しトロイダル磁心を作製した。次に、この磁心を窒素ガス雰囲気中で、550℃で1h磁界をかけずに熱処理し、室温まで空冷した。熱処理後、磁心を構成する合金薄帯の形成相および組織を観察したところ、大部分が100~200かり入り一人程度のbccFeの超微結晶粒からなっていた。得られた磁心の外表面をポリパラキシリレン系樹脂でコーティングした後、エッジ部に0.2mmの面取加工を施し、再度ポリパラキシリレン系樹脂でコーティングし、磁心外表面のコーティング肉厚を20μm、エッジ部のコーティング肉厚を5μmに調整した。インピーダンスアナライザを用いて周波数20kHzのインダクタンス係数、また、磁心に1次、2次巻線を施して、絶縁*

*耐圧試験器を用いてコイルの絶縁耐圧を測定した。

【0017】(比較例1)比較例として実施例1と同じ方法で超微結晶軟磁性合金薄帯からなるトロイダル磁心を作製した。得られた磁心の外表面をポリパラキシリレン系樹脂でコーティングし、面取加工を施さず磁心外表面のコーティング肉厚を25μmに調整した。この時のエッジ部の肉厚は2μmであった。実施例1と同様の方法でインダクタンス係数および絶縁耐圧を測定した。

【0018】実施例1および比較例1の測定結果を表1に示す。本発明の長方形断面のエッジ部を面取加工した磁心がインダクタンス係数が高く、絶縁耐圧に優れていることが確認された。

[0019]

【表1】

	面取り寸法 (mm)	エッジ部の 肉厚(μm)	インダクタンス 係数(μH/N²)	絶縁耐圧 (kV)
実施例1	0.2	- 5	12 .3	4.6
比較例1	. 0	2	11.9	0.9

エッジ部の肉厚:コーティング層肉厚

【0020】 (実施例 $2\sim11$) 実施例1と同じ方法で超微結晶軟磁性合金薄帯からなるトロイダル磁心を作製した。得られた磁心外表面をエポキシ系樹脂でコーティングした後、エッジ部にそれぞれ $0.05\,\mathrm{mm}$ 、 $0.5\,\mathrm{mm}$ 、 $0.3\,\mathrm{mm}$ 、 $0.35\,\mathrm{mm}$ 、 $0.4\,\mathrm{mm}$ 、 $0.5\,\mathrm{mm}$ 、 $0.6\,\mathrm{mm}$ 、 $0.7\,\mathrm{mm}$ 、 $0.8\,\mathrm{mm}$ の面取加工を施し、再度エポキシ系樹脂でコーティングし、磁心外表面のコーティング肉厚を $25\,\mu\mathrm{m}$ 、エッジ部の $25\,\mathrm{mm}$

※コーティング肉厚は $1\sim10\mu$ mであった。実施例1と同様の方法でインダクタンス係数および絶縁耐圧を測定した。測定結果を表2に示すが、エッジ部の面取り寸法が $0.1\sim0.5$ mmの場合にインダクタンス係数が高く、かつ絶縁耐圧が高いことが判明した。

[0021]

【表2】

	面取り寸法 (mm)	エッジ部の 肉厚(μm)	インダクタンス 係数(μH/N²)	絶縁耐圧 (kV)
実施例2	0.05	1	9.8	1.1
- 3	0.08	1.3	9.9	1.3
4	0.1	5	14.7	3.8
5	0.3	6.5	14.3	4.1
6	0.35	7.1	13.1	4.3
7	0.4	8.2	12.8	4.6
8	0.5	10	12.6	4.7
9	0.6	2.6	7.8	2.3
10	0.7	3.5	7.5	2.4
11	0.8	4	6.3	2.2

エッジ部の肉厚:コーティング層肉厚

【0022】(実施例12~19) 実施例1と同じ方法で超微結晶軟磁性合金薄帯からなるトロイダル磁心を作製した。得られた磁心をポリパラキシリレン系樹脂でコーティングした後、エッジ部に0.3 mmの面取加工を施した後、再度ポリパラキシリレン系樹脂でコーティングし、磁心外表面のコーティング肉厚を、10μm、2

 $0 \mu m$ 、 $3 0 \mu m$ 、 $5 0 \mu m$ 、 $6 0 \mu m$ 、 $7 0 \mu m$ 、 $8 0 \mu m$ 、 $1 0 0 \mu m$ に調整した。尚、エッジ部のコーティング肉厚は $5 \sim 9 0 \mu m$ であった。実施例1と同様の方法でインダクタンス係数、絶縁耐圧および磁心の高さを測定した。測定結果を表3に示すが、磁心外表面のコーティング肉厚が $1 0 \sim 5 0 \mu m$ 、特に $2 0 \sim 3 0 \mu m$ である

	コーティング 肉厚(mm)	インダクタンス 係数(μH/N²)	絶緣耐圧(kV)	磁心の 高さ (mm)
実施例12	10	13.0	4.0	1.9
13	20	14.7	4.3	2.1
14	30	14.1	4.4	2.3
15	50	12.8	4.6	2.8
16	60 .	7.0	3.1	3.2
. 17	70	6.7	3.3	3.5
18	80	5.2	3.4	3.7
. 19	100	4.9	3.5	4.3

【0024】 (実施例20~25) 表4に示す組成の合 金溶湯を単ロール法により急冷し、幅0.5mm、厚さ 5 μ m の非晶質合金薄帯を作製した。得られた非晶質合 金薄帯の両面にSiO2の層間絶縁膜を約2μm塗布した後、 外径15mm、内径4mmに巻回し、トロイダル磁心を 作製した。次に、この磁心をアルゴンガス雰囲気中で熱 20 処理し空冷した。熱処理は磁性薄帯の幅方向に3.5kA/ mの磁界を印加しながら、各合金に対する最適条件で行 った。熱処理後、磁心を構成する合金薄帯の形成相およ び組織を観察したところ、大部分が100~2001ング ストローム程度のbccFeの超微結晶粒からなっていた。得られ た磁心をポリパラキシリレン系樹脂でコーティングした 後、エッジ部に0.15mmの面取加工を施し、再度ポ リパラキシリレン系樹脂でコーティングし、磁心外表面 のコーティング肉厚を30μm、エッジ部のコーティン グ肉厚を10μmに調整した。実施例1と同様の方法で インダクタンス係数および絶縁耐圧を測定した。

【0025】(比較例2、3)比較例として表4に示す 合金溶湯を単ロール法により急冷し、幅0.5mm、厚 ※ ※さ5μ $^{\text{m}}$ の非晶質合金薄帯を作製した。得られた非晶質合金薄帯の両面にSiO $^{\text{m}}$ の層間絶縁膜を約2μ $^{\text{m}}$ 塗布した後、外径15 $^{\text{m}}$ m、内径4 $^{\text{m}}$ mに巻回し、トロイダル磁心を作製した。次に、この磁心をアルゴンガス雰囲気中で熱処理し空冷した。熱処理は磁性薄帯の幅方向に3.5 $^{\text{k}}$ A $^{\text{m}}$ の磁界を印加しながら、各合金に対する最適条件で行った。得られた磁心をポリパラキシリレン系樹脂でコーティングした後、エッジ部に0.15 $^{\text{m}}$ mの面取加工を施し、再度ポリパラキシリレン系樹脂でコーティングし、磁心外表面のコーティング肉厚を30 $^{\text{m}}$ m、エッジ部のコーティング肉厚を10 $^{\text{m}}$ mに調整した。実施例1と同様の方法でインダクタンス係数および絶縁耐圧を測定した。

【0026】実施例20~25および比較例2、3の測定結果を表4に示す。本発明はいずれの超微結晶軟磁性合金にも適用でき、本発明の磁心がインダクタンス係数が高く、かつ絶縁耐圧が高いことが分かった。

[0027]

【表4】

	合金組成(原子%)	インダクタンス 係数(μH/N²)	絶縁耐圧(kV)
実施例20	Fe74Cu1Nb3Si1eBe	12.9	4.8
21	Fe ₇₂ Cu ₁ V _e Si ₁₃ B _e	13.8	4.5
22	FeeeNi4Nb3Si4Al4Be	11.9	4.7
23	Fees Ni4Zr1.5Sis.sAl7Bs	14.5	4.0
24	Fero.sCuiNbaCraSiia.sBe	12.7	4.9
25	FeasCuiZr-Bs	13.6	4.3
比較例 2	Fe ₇₈ Si ₁₀ B ₁₂	4.6	1.5
3	Co71Fe4Si10B15	5.1	1.3

[0028]

【発明の効果】本発明によれば、高インダクタンスで、 絶縁耐圧に優れる薄型磁心が得られるため、インターフ ェース用等のパルストランスあるいはノイズフィルタ用 チョーク等に使用することにより、従来よりも高性能な 磁心を提供することが可能である。

フロントページの続き

(72)発明者 荒川 俊介

埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式 会社磁性材料研究所内 (72)発明者 三木 裕彦

鳥取県鳥取市南栄町33番地12号日立フェラ

イト株式会社鳥取工場内

(72)発明者 玉飼 俊之

東京都文京区西片一丁目17番8号日立フェ

ライト株式会社内